

研究简报

InGaAsP/InP双异质结发光管中的深能级

张桂成, 吴征

中国科学院上海冶金研究所 上海

收稿日期 1987-7-13 修回日期 1988-2-15 网络版发布日期 2010-4-2 接受日期

摘要

本文用DLTS谱仪研究了SiO₂限制的InGaAsP/InP双异质结发光管中的深能级。结果表明:只有在*p-n*结位于*p-InP/n-InGaAsP*界面处的个别器件中,有 $\Delta E=0.24\text{eV}$ 的多子陷阱。

关键词 [发光管](#) [InGaAsP/InP](#) [双异质结发光管](#) [深能级](#)

分类号

DEEP LEVEL IN InGaAsP/InP DH LED

Zhang Guicheng, Wu Zhen

Shanghai Institute of Metallurgy, Academia Sinica, Shanghai

Abstract

The deep level in InGaAsP/InP DH LED have been studied by DLTS method. The results show that when the *p-n* junction located in the interface of the *p-InP/n-In GaAsP*, there is deep level in some InGaAsP/InP DH LED. The activation energy ΔE is 0.24eV.

Key words [LED](#) [InGaAsP/InP](#) [double heterojunction LED](#) [Leep level](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 张桂成; 吴征

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(674KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“发光管”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张桂成](#)

· [吴征](#)